

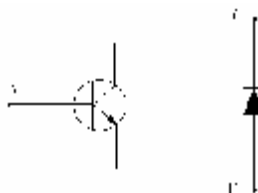
# 11004

## 硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

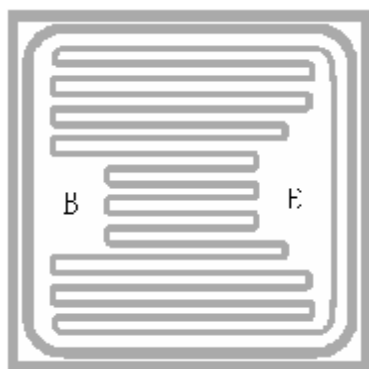
### ■ 用途

主要用于 110V 节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

### ■ 内部结构



### ■ 芯片示意图



### ■ 芯片结构

芯片尺寸	1600μm×1600μm
压焊区尺寸	基区 300μm×420μm 发射区 310μm×640μm
芯片厚度	240±10μm
锯片槽宽度	90μm
金属层	正面: Al 3.5±0.4μm 背面: Ag 1.4±0.2μm

### ■ 电特性(T<sub>a</sub>=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	典型值	单位
集电极-基极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =350V		1		μA
发射极-基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =9V		5		μA
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CB0</sub>	I <sub>C</sub> =0.1mA	350			V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CE0</sub>	I <sub>C</sub> =1mA	220			V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EB0</sub>	I <sub>E</sub> =0.1mA	9			V
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =500mA	10	40		
集电极-发射极饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =500mA, I <sub>B</sub> =100mA		0.5		V
基极-发射极饱和电压	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =500mA, I <sub>B</sub> =100mA		1		V
特征频率	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =200mA	5			MHz

\* 该产品有保护二极管